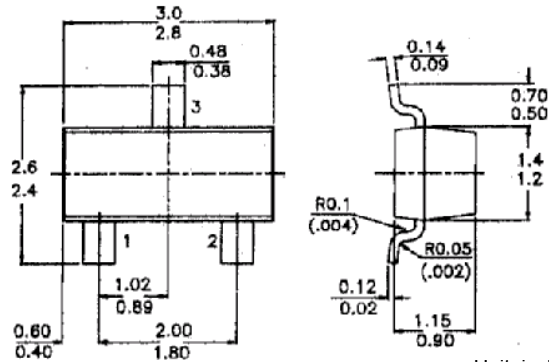
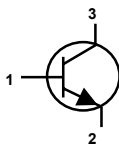


NPN Silicon Planar Epitaxial Transistors

Pin configuration:
 1. BASE
 2. EMITTER
 3. COLLECTOR



Unit: inch (mm)

SOT-23 SMD Package

Absolute Maximum Ratings ($T_a = 25^\circ\text{C}$ unless specified otherwise)

DESCRIPTION	SYMBOL	BC846	BC847	BC848	UNITS
Collector Base Voltage	V_{CBO}	80	50	30	V
Collector Emmitter Voltage ($V_{BE} = 0V$)	V_{CES}	80	50	30	V
Collector Emitter Voltage	V_{CEO}	65	45	30	V
Emitter Base Voltage	V_{EBO}	6	6	5	V
Collector Current (DC)	I_C		100		mA
Collector Current - Peak	I_{CM}		200		mA
Emitter Current - Peak	$-I_{EM}$		200		mA
Base Current - Peak	I_{BM}		200		mA
Total power dissipation up to $T_{amb} = 25^\circ\text{C}$	P_{tot}^{**}		250		mW
Storage Temperature	T_{stg}		-55 to +150		$^\circ\text{C}$
Junction Temperature	T_j		150		$^\circ\text{C}$

Thermal Resistance

From junction to ambient	$R_{th(j-a)}^{**}$	500		K/W
--------------------------	--------------------	-----	--	-----

**Mounted on a ceramic substrate of 8mm x 10mm x 0.7mm

Electrical Characteristics (at Ta=25 °C unless otherwise specified)

DESCRIPTION	SYMBOL	TEST CONDITION	MIN	TYP	MAX	UNITS	
Collector Cut Off Current	I_{CBO}	$V_{CB} = 30V, I_E = 0$			15	nA	
		$V_{CB} = 30V, I_E = 0, T_j = 150^\circ C$			4	uA	
Base Emitter On Voltage	$V_{BE(on)}^*$	$I_C = 2mA, V_{CE} = 5V$	0.58		0.7	V	
		$I_C = 10mA, V_{CE} = 5V$			0.77		
Collector Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(Sat)}$	$I_C = 10mA, I_B = 0.5mA$			0.25	V	
		$I_C = 100mA, I_B = 5mA$			0.60		
Base Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(Sat)}^{***}$	$I_C = 10mA, I_B = 0.5mA$		0.7		V	
		$I_C = 100mA, I_B = 5mA$		0.9			
DC Current Gain	h_{FE}	$I_C = 10uA, V_{CE} = 5V$					
		BC846A/BC847A/BC848A		90			
		BC846B/BC847B/BC848B		150			
		BC847C/BC848C		270			
		$I_C = 2mA, V_{CE} = 5V$					
		BC846	110	450			
		BC847/BC848	110	800			
Collector Capacitance	C_C	$I_E = i_e = 0, V_{CB} = 10V, f = 1MHz$		2.5		pF	
Transition Frequency	f_T	$I_C = 10mA, V_{CB} = 5V, f = 100MHz$	100			MHz	
Small Signal Current Gain	$ h_{fe} $	$I_C = 2mA, V_{CE} = 5V, f = 1kHz$					
			BC856	125	500		
			BC857/BC858	125	900		
			BC846A/BC847A/BC848A	125	260		
			BC846B/BC847B/BC848B	240	500		
BC847C/BC848C	450	900					
Noise Figure	NF	$I_C = 0.2mA, V_{CE} = 5V$ $R_S = 2k\ ohm, f = 1kHz, B = 200Hz$		10		dB	

* $V_{BE(on)}$ decreases by about 2mV/K with increase temperature.

*** $V_{BE(Sat)}$ decreases by about 1.7mV/K with increase temperature.



Стандарт Электрон Связь

Мы молодая и активно развивающаяся компания в области поставок электронных компонентов. Мы поставляем электронные компоненты отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших складов мира.

Благодаря сотрудничеству с мировыми поставщиками мы осуществляем комплексные и плановые поставки широчайшего спектра электронных компонентов.

Собственная эффективная логистика и склад в обеспечивает надежную поставку продукции в точно указанные сроки по всей России.

Мы осуществляем техническую поддержку нашим клиентам и предпродажную проверку качества продукции. На все поставляемые продукты мы предоставляем гарантию .

Осуществляем поставки продукции под контролем ВП МО РФ на предприятия военно-промышленного комплекса России , а также работаем в рамках 275 ФЗ с открытием отдельных счетов в уполномоченном банке. Система менеджмента качества компании соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001.

Минимальные сроки поставки, гибкие цены, неограниченный ассортимент и индивидуальный подход к клиентам являются основой для выстраивания долгосрочного и эффективного сотрудничества с предприятиями радиоэлектронной промышленности, предприятиями ВПК и научно-исследовательскими институтами России.

С нами вы становитесь еще успешнее!

Наши контакты:

Телефон: +7 812 627 14 35

Электронная почта: sales@st-electron.ru

Адрес: 198099, Санкт-Петербург,
Промышленная ул, дом № 19, литера Н,
помещение 100-Н Офис 331